

三菱半導体(トランジスタ)

# 2SA1364

低周波電力増幅用  
シリコンPNPエピタキシャル形

## 概要

2SA1364は、樹脂封止形シリコンPNPエピタキシャル形トランジスタです。耐圧が高い、コレクタ電流が大きい、さらにコレクタ損失が大きく、設計、製造されておりますので、リレードライブや電源等の汎用トランジスタとして、ご使用いただけます。

また、コレクタフィンが外部に出ており基板に直接半田付することによりコレクタ許容損失が向上します。

2SC3444とコンプリメンタリです。

## 特長

- 小形外形のためセットの小形化、高密度実装が可能
- 耐圧が高い  $V_{CE0} = -60V$
- コレクタ電流が大きい  $I_C = -1A$
- $V_{CE(sat)}$  が低い  $V_{CE(sat)} = -0.11V$  標準  
( $@I_C = -500mA, I_B = -25mA$ )
- コレクタ損失が大きい  $P_C = 500mW$

## 用途

オーディオ機器、VTR、電装機器、その他電子機器のリレードライブ、電源

## 最大定格 ( $T_a = 25^\circ C$ )

記号	項目	定格値	単位
$V_{CB0}$	コレクタ・ベース間電圧	-60	V
$V_{EB0}$	エミッタ・ベース間電圧	-6	V
$V_{CE0}$	コレクタ・エミッタ間電圧	-60	V
$I_C$	コレクタ電流	-1	A
$I_{CM}$	せん頭コレクタ電流	-2	A
$P_C$	コレクタ損失 ( $T_a = 25^\circ C$ )	500	mW
$T_j$	接合部温度	+150	$^\circ C$
$T_{stg}$	保存温度	-55 ~ +150	$^\circ C$

## 電気的特性 ( $T_a = 25^\circ C$ )

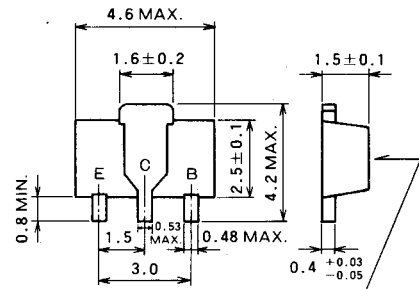
記号	項目	測定条件	特性値			単位
			最小	標準	最大	
$V_{(BR)CB0}$	コレクタ・ベース降伏電圧	$I_C = -10\mu A, I_E = 0$	-60			V
$V_{(BR)EB0}$	エミッタ・ベース降伏電圧	$I_E = -10\mu A, I_C = 0$	-6			V
$V_{(BR)CE0}$	コレクタ・エミッタ降伏電圧	$I_C = -2mA, R_{BE} = \infty$	-60			V
$I_{CB0}$	コレクタシャ断電流	$V_{CB} = -50V, I_E = 0$			-0.2	$\mu A$
$I_{EB0}$	エミッタシャ断電流	$V_{EB} = -4V, I_C = 0$			-0.2	$\mu A$
$h_{FE} \uparrow$	直流電流増幅率	$V_{CE} = -4V, I_C = -0.1A$	55		300	-
$V_{CE(sat)}$	コレクタ・エミッタ飽和電圧	$I_C = -500mA, I_B = -25mA$		-0.11	-0.3	V
$f_T$	利得帯域幅積	$V_{CE} = -2V, I_E = 10mA$		85		MHz
$C_{ob}$	コレクタ出力容量	$V_{CB} = -10V, I_E = 0, f = 1MHz$		22		pF

↑:  $h_{FE}$ の値により右表のようにアイテム分類を行っています。

マーキング	CC	CD	CE
$h_{FE}$	55~110	90~180	150~300

## 外形図

単位: mm



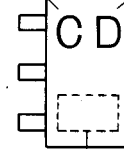
### 電極接続

E: エミッタ  
C: コレクタ  
B: ベース  
(SOT-89)

(注1) 公差指定のない寸法は代表値を示す。

## マーク図

形名表示 hFEアイテム



ロット No.